

Секція 3. Радіаційна фізика та радіаційне матеріалознавство.

Детектор ядерних випромінювань на основі перспективного напівпровідникового матеріалу $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$.

Литовченко П.Г., Барабаш Л.І., Бердиченко С.В., Варенцов М.Д., Гайдар Г.П., Долголенко А.П., Дубовий В.К., Карпенко А.Я, Кібкало Т.І., Кочкін В.І., Ластовецький В.Ф., Полівцев Л.А., Старчик М.І.

Відділ радіаційної фізики Інституту Ядерних Досліджень НАН України
e-mail: ayak@kinr.kiev.ua

Наведені характеристики детектора ядерних випромінювань на основі $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$, як перша спроба практичного застосування цього перспективного напівпровідникового матеріалу.

Тривалість доповіді 10хв.